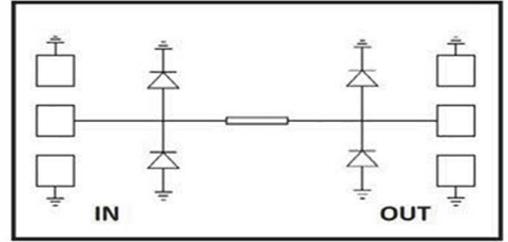


## GaAs 限幅器芯片 DC-4GHz

## 主要性能

- ◎ 工作频段: DC ~ 4GHz
- ◎ 插入损耗: 0.25 dB
- ◎ 限幅电平: 14 dBm
- ◎ 最大输入功率: 68.4W (CW)
- ◎ 芯片尺寸: 1.72 x 0.927 x 0.1mm

## 功能框图



## 产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围:

- ◎ 无线通信设备
- ◎ 军事和航天
- ◎ 测试仪器
- ◎ 雷达和电子对抗

## 极限参数

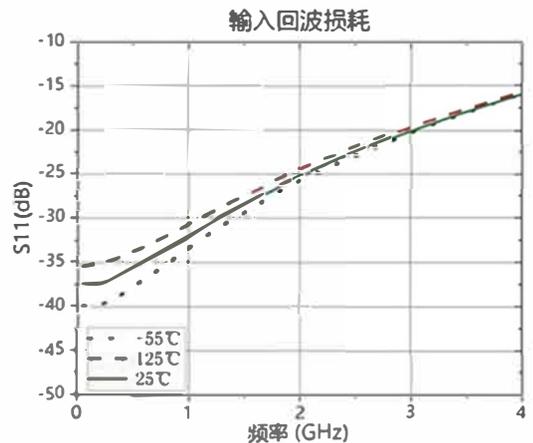
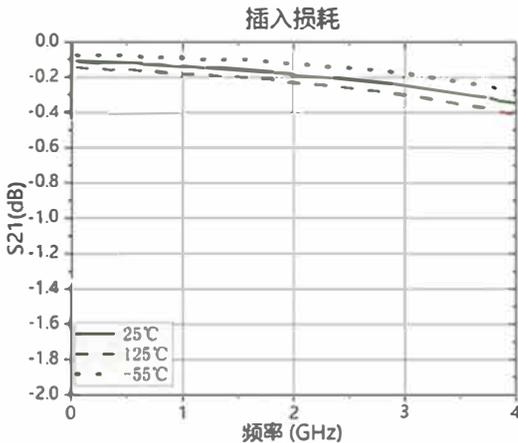
指标	数值	备注
最大输入功率	77W	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

注: 超过最大值都有可能造成永久性损坏

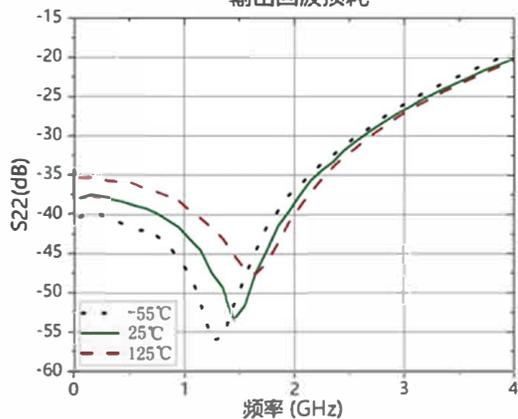
## 电性能表 (TA = +25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.25	-	dB
回波损耗	-	25	37	dB
限幅电平	-	14	-	dBm
最大输入功率	-	68.4	-	W

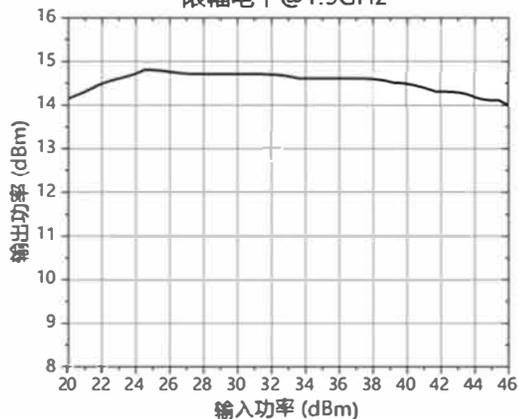
## 典型测试曲线



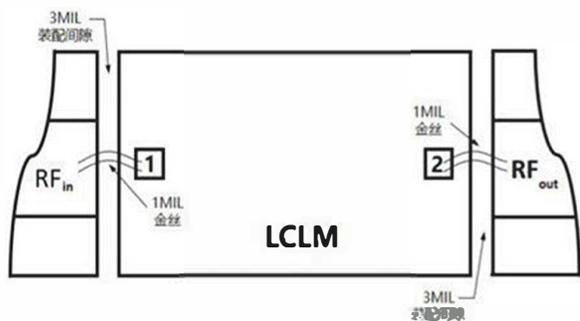
输出回波损耗



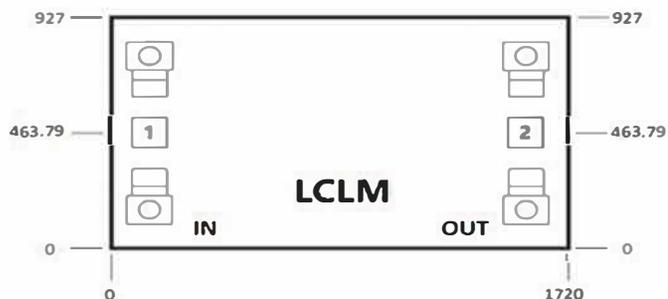
限幅电平@1.5GHz



## 装配示意图



## 芯片尺寸图



## 说明:

1. 单位: 微米 ( $\mu\text{m}$ ), 尺寸公差:  $\pm 50\mu\text{m}$
2. 键合压点镀金, 压点尺寸:  $100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 不可在通孔上进行键合
6. 压点间隔:  $150\mu\text{m}$  (GSG)

## 键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RF <sub>in</sub>	RF 输入端, 阻抗 $50\Omega$ (建议外接隔直电容)
2	RF <sub>out</sub>	RF 输出端, 阻抗 $50\Omega$ (建议外接隔直电容)
-	GND	芯片背面必须接地